

Silicon Diode

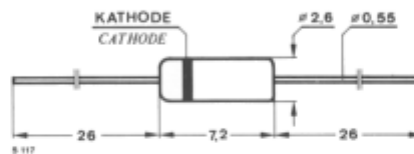
BAY67

35V / 200mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1977

BAY 67**Silizium-Diffusions-Diode**
Silicon diffusion diode**Anwendungen:** HF-Schaltdiode**Applications:** *Switching RF signals***Abmessungen in mm**
Dimensions in mm

Normgehäuse
Case
51 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 7
Gewicht · Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung <i>Repetitive peak reverse voltage</i>	U_{RRM}	35	V
Sperrspannung <i>Reverse voltage</i>	U_R	35	V
Durchlaßstrom <i>Forward current</i>	I_F	200	mA
Verlustleistung <i>Power dissipation</i> $l = 4 \text{ mm}, t_L \leq 25^\circ\text{C}$	P_V	250	mW
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	t_j	175	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	t_{stg}	-55...+175	$^\circ\text{C}$

BAY 67

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperschicht-Umgebung
Junction ambient
 $l = 5 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA} 420 °C/W

Kenngößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage
 $I_F = 200 \text{ mA}$

$U_F^*)$ 1 V

Sperrstrom
Reverse current
 $U_R = 35 \text{ V}$
 $U_R = 35 \text{ V}$, $t_j = 150^\circ\text{C}$

$I_R^*)$ 100 nA
 $I_R^{**})$ 50 μA

Diodenkapazität
Diode capacitance
 $U_R = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ MHz}$

C_D 0,8 1,5 pF

Differentieller Durchlaßwiderstand
Differential forward resistance
 $I_F = 5 \text{ mA}$
 $I_F = 10 \text{ mA}$
 $I_F = 50 \text{ mA}$

r_f 9,5 Ω
 r_f 4 5 6 Ω
 r_f 1,3 Ω

*) AQL = 0,65%

**) AQL = 2,5%

BAY 67

